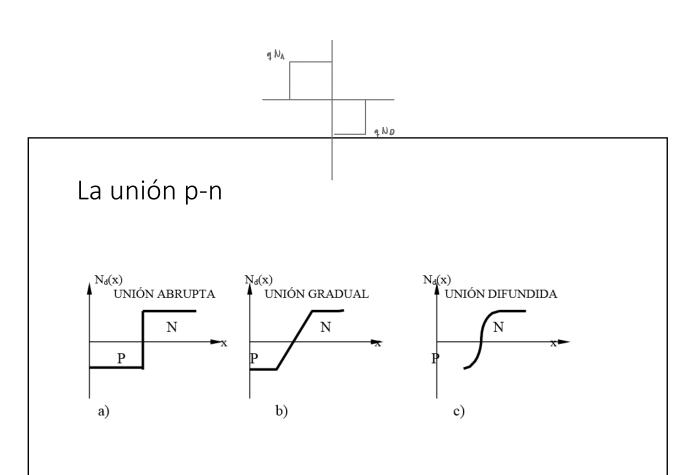


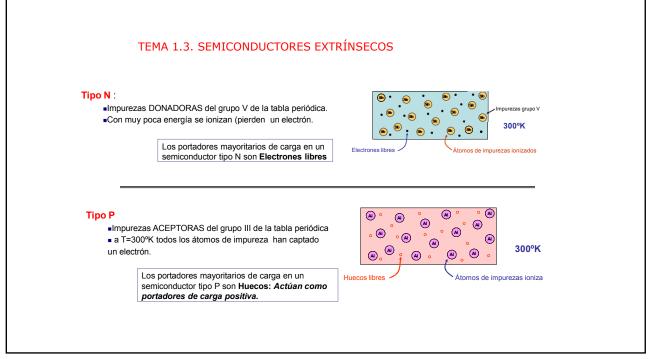
1

1. INTRODUCCIÓN

- Se dice que en una pastilla semiconductora existe una unión p -n cuando la concentración neta de impurezas, definida como Nd (x) = ND (x) NA (x), es positiva en una parte de dicha pastilla (zona n) y negativa en la otra (zona p).
- Se aprecia un perfil de impurezas donadoras y aceptoras, ND(x) y NA (x).

2





Tema 1.10 DENSIDADES DE CARGA EN UN S/C EXTRINSECO

Leyes de acción de masas y de cuasi-neutralidad eléctrica. $n \times p = n_1^2 \qquad N_A + n = N_D + p \qquad N_A : dens. impurezas aceptoras N_D : dens. impurezas donadoras$

$$n \times p = n_i^2$$

$$N_A + n = N_D + p$$

□ Semiconductor intrínseco:

$$N_A = N_D = 0 \rightarrow p = n = n_i$$

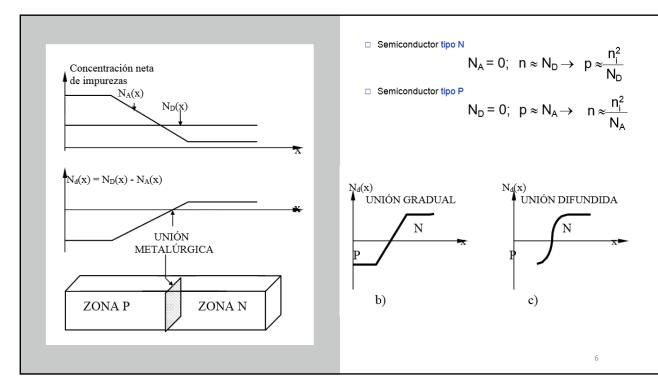
□ Semiconductor tipo N

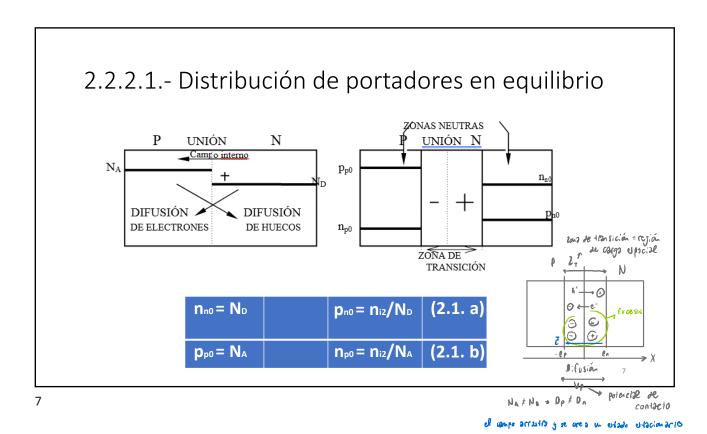
$$N_A = 0$$
; $n \approx N_D \rightarrow p \approx \frac{n_i^2}{N_D}$

□ Semiconductor tipo P

$$N_D = 0; p \approx N_A \rightarrow n \approx \frac{n_i^2}{N_\Delta}$$

5





2.2.2.- Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio. 4 40 b P N $\rho(x)$ l_{T} ZONA ZONA qN_D NEUTRA NEUTRA x=0 x>0 x<0 x<0 -1_p x>0 Siendo $\rho(x)$ la densidad de carga

2.2.2.2. Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio.

$$\begin{split} E(x=-\underline{l_p}) &= -(1/\varepsilon) \cdot \underline{q} \cdot N_A \cdot (-l_p) + K_1 = 0 \\ & \Longrightarrow \qquad K_1 = -(1/\varepsilon) \cdot \underline{q} \cdot N_A \cdot l_p \\ \\ E(x=l_n) &= (1/\varepsilon) \cdot \underline{q} \cdot N_D \cdot (l_n) + K_2 = 0 \implies \qquad K_2 = -(1/\varepsilon) \cdot \underline{q} \cdot N_D \cdot l_n \end{split}$$

9

q

2.2.2.- Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio.

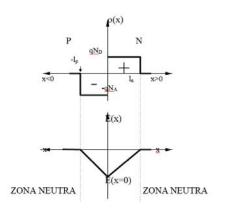
$$E(x=0) = -(1/\epsilon) \cdot q \cdot N_A \cdot (0 + l_p) = (1/\epsilon) \cdot q \cdot N_D \cdot (0 - l_n)$$

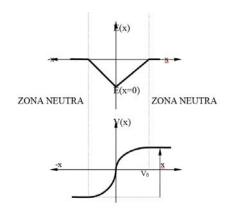
De donde se obtiene:

$$N_{A} \cdot l_{p} = N_{D} \cdot l_{n} \tag{2.5.}$$

10

2.2.2.- Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio.





2.2.2.- Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio.

$$V(x) = -\int E(x)dx$$

$$V(x) = (1/\underline{\underline{\epsilon}}) \cdot \underline{q} \cdot \underline{N}_{A} \cdot (x^{2}/2 + l_{p} \cdot x) + K_{3} \qquad -l_{p} \le x \le 0$$

$$V(x) = -(1/\underline{\underline{\epsilon}}) \cdot \underline{q} \cdot \underline{N}_{D} \cdot (x^{2}/2 - l_{n} \cdot x) + K_{4} \qquad \underline{si} \quad 0 \le x \le l_{n}$$

$$(2.6.)$$

2.2.2.- Distribución de campo y potencial eléctricos en equilibrio.

- Para determinar las constantes de integración, K3 y K4, fijamos el punto x=0 como referencia de potencial, esto es hacer V(x=0).
- De esta forma K3 = K4 = 0. Con esta consideración se ha representado la función potencial en la figura 2.5
- En la misma figura se puede apreciar que en las zonas neutras el potencial permanece constante (consecuencia directa de la neutralidad de las mismas y de que el campo sea nulo en ellas).
- La diferencia de potencial entre ambas zonas neutras se denomina potencial de contacto o termodinámico (V0).

13

13

Potencial de contacto de una unión p-n en equilibrio

$$V(x_2) - V(x_1) = K \cdot T/q \cdot \ln[p(x_1)/p(x_2)] = K \cdot T/q \cdot \ln[n(x_2)/n(x_1)]$$
 (2.7.)

$$\begin{split} & V_{0} = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{p_{p0}}{p_{n0}} = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{K \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{N_{A} \cdot N_{D}}{n_{i}^{2}} \\ & V_{0} = V(-\ell_{P}) - V(\ell_{A}) \quad \overset{\text{(i)}}{\underset{}{\mathcal{N}}} \stackrel{N_{n0}}{\underset{}{\mathcal{N}}} = N_{D}; \; \rho_{ni} = \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} \; (\text{despeciable}) \\ & \stackrel{\text{(2.8.)}}{\underset{}{\mathcal{N}}} \quad \rho_{P} = N_{A}; \; \rho_{P} = \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}} \; (\text{despeciable}) \end{split}$$

Potencial de contacto de una unión p-n en equilibrio:

 $V_0 = (1/2) \cdot |E(x=0)| \cdot (l_n + l_p) = (1/2) \cdot |E(x=0)| \cdot l_T$ (2.9.)

Es decir que si calculamos el potencial de contacto mediante la expresión (2.8.), al aplicar la ecuación anterior combinada con la (2.5.) podremos determinar la anchura total de la zona de transición (l_T), así como la anchura de la misma por cada uno de los lados de la unión (l_p y l_n):

$$\ell_{\beta^{\star}}\ell_{\alpha}\text{ }\text{ }\text{ }1_{T}=\frac{2^{\bullet}V_{0}}{\left|E(x=0)\right|}=\frac{2^{\bullet}V_{0}^{\bullet}\bullet\in}{q^{\bullet}N_{A}^{\bullet}1_{p}}=\frac{2^{\bullet}V_{0}^{\bullet}\bullet\in}{q^{\bullet}N_{D}^{\bullet}1_{n}}$$

$$N_A\!\cdot\! l_p = N_D\!\cdot\! l_n = N_D\!\cdot\! (l_T\!\!-\! l_p) = N_A\!\cdot\! (l_T\!\!-\! l_n)$$

De donde se deduce fácilmente que: (V - Vo)

$$\ell_{T} = \left[\frac{2 \bullet \in \bullet(N_{A} + N_{B})}{q \bullet N_{A} \bullet N_{B}} \bullet Vo\right]^{1/2}$$
(2.10)

15

15

2.3 La unión p-n polarizada

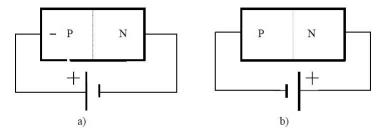


Figura F-2.8.a) y b).- Polarización directa e inversa de una unión p-n.

2.3 La unión p-n polarizada

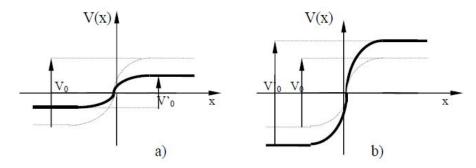


Figura F-2.9.a) y b).- Variación de la barrera de potencial al polarizar la unión p-n en directo e inverso, respectivamente.

2.3 La unión p-n polarizada

$$V'_0 = V_0 - V$$

$$\ell_T = \left[\frac{2 \bullet \in \bullet(N_A + N_B)}{q \bullet N_A \bullet N_B} \bullet (Vo - V) \right]^{1/2}$$
 (2.12.)

